

★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 国清辰也 副委員長 品田高宏

幹事 黒田理人・山口 直 幹事補佐 池田浩也・諸岡 哲

日時 1月30日(火) 11:00~16:30

会場 機械振興会館地下3階研修1号室(港区芝公園3-5-8. 東京メトロ日比谷線; 神谷町駅下車, 徒歩8分. <http://www.jspmi.or.jp/kaigishitsu/access.html>)

議題 先端 CMOS デバイス・プロセス技術 (IEDM 特集)

1. [招待講演] Perspective of Negative Capacitance FinFETs Investigated by Transient TCAD Simulation
太田裕之 (産総研)
2. [招待講演] Proposal and demonstration of oxide-semiconductor/(Si, SiGe, Ge) bilayer tunneling field effect transistor with type-II energy band alignment 加藤公彦 (東大)

午後 (13:30~)

3. [招待講演] Lateral Charge Migration Suppression of 3D-NAND Flash by Vth Nearing for Near Data Computing
溝口恭史 (東大)
4. [招待講演] Reliability and Scalability of FinFET Split-Gate MONOS Array with Tight Vth Distribution for 16/14 nm-node Embedded Flash 津田是文 (ルネサス エレクトロニクス)
5. [招待講演] STDP synapse with outstanding stability based on a novel insulator-to-metal transition FET
Pablo Stoliar (産総研)
6. [招待講演] Sub-nm EOT Ferroelectric HfO₂ on p+Ge with Highly Reliable Field Cycling Properties
Xuan Tian (東大)
7. [招待講演] IEDM2017 を振り返って 高柳万里子 (東芝)

◆応用物理学会共催

☆SDM 研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

2月 8日(木) 東大本郷キャンパス [締切済] テーマ:配線・実装技術と関連材料技術

2月28日(水), 3月1日(木) 北大百年記念会館 [締切済] テーマ:機能ナノデバイス及び関連技術

【問合先】

黒田理人 (東北大)

TEL [022] 795-4833, FAX [022] 795-4834

E-mail: rihito.kuroda.e3@tohoku.ac.jp